

**A.F. POWER TRANSISTOR N-P-N**  
**NF-LEISTUNGSTRANSISTOREN N-P-N**

Type Typ	Maximum ratings ● Grenzdaten						$I_{CBO}$ at $U_{CB}$	$h_{21E}$ at $U_{CB}$	$I_C$	$U_{BE\ sat}$	$U_{CE\ sat}$	$f_T$	Case Gehäuse	
	$U_{CEO}$	$U_{EBO}$	$I_C$	$I_B$	$P_{tot}$	$\vartheta_j$	$I_{CER\ max}$ bei $U_{CE}^*$	bei	A	$U_{BE\ max}^*$	max	min		
	V	V	A	A	W	°C	mA	V	A	V	V	MHz		
<b>KD501</b>	40	5	20	7	150 <sup>5)</sup>	155	0,5 10*	40 > 15	2 2	1 15	— 1,7 <sup>1)</sup>	— 0,75 <sup>1)</sup>	2 —	T41
<b>KD502</b>	60	5	20	7	150 <sup>5)</sup>	155	0,5 10*	60 > 15	2 2	1 15	— 1,7 <sup>1)</sup>	— 0,75 <sup>1)</sup>	2 —	T41
<b>KD503</b>	80	5	20	7	150 <sup>5)</sup>	155	0,5 10*	80 > 15	2 2	1 15	— 1,7 <sup>1)</sup>	— 0,75 <sup>1)</sup>	2 —	T41
<b>KD601</b>	24	5	10	1	35 <sup>4)</sup>	200	10	24 > 17 <sup>7)</sup>	6	0,1	2,4 <sup>1)</sup>	1,3 <sup>2)</sup> 2,4 <sup>1)</sup>	10	T37
<b>KD602</b>	110 <sup>8)</sup>	5	8	1	35	155		15 ... 50	2	4	2,4 <sup>3)</sup>	2 <sup>3)</sup>	0,5	T37
<b>KD605</b>	40	5	10	2	70 <sup>6)</sup>	155	0,5	40 > 10	2 2	1 10	— 2,4 <sup>1)</sup>	— 2 <sup>1)</sup>	2 —	T39
<b>KD606</b>	60	5	10	2	70 <sup>6)</sup>	155	0,5	60 > 10	2 2	1 10	— 2,4 <sup>1)</sup>	— 2 <sup>1)</sup>	2 —	T39
<b>KD607</b>	80	5	10	2	70 <sup>6)</sup>	155	0,5	80 > 10	2 2	1 10	— 2,4 <sup>1)</sup>	— 2 <sup>1)</sup>	2 —	T39
<b>KD3055</b>	60	7	15	7	117	200	0,7*	30* > 5	4 4	4 10	1,8*	1,1 <sup>9)</sup> 5,0 <sup>10)</sup>	1	T42
<b>KD3442</b>	140	7	10		117	200	1,0	140 > 7,5	4 4	3 10	1,7* <sup>11)</sup> 5,7* <sup>12)</sup>	1,0 <sup>11)</sup> 5,0 <sup>12)</sup>	1	T42
<b>KD3772</b>	60	7	20	5	150	200	5,0	100	4	10	2,2*	1,4 <sup>1)</sup>	1	T42
<b>KD3773</b>	140	7	16	4	150	200	10	120 > 5	4 4	8 16	2,2*	4,0 <sup>13)</sup>	1	T42
<b>KD4348</b>	120	7	10	4	120	200	10	100 > 10	4 4	5 10	2,0*	2,0 <sup>14)</sup>	1	T42

<sup>1)</sup>  $I_C = 4\text{ A}$ ,  $I_B = 1\text{ A}$

<sup>2)</sup>  $I_C = 4\text{ A}$ ,  $I_B = 0,1\text{ A}$

<sup>3)</sup>  $I_C = 8\text{ A}$ ,  $I_B = 0,8\text{ A}$

<sup>4)</sup>  $\vartheta_c = \leq 45^\circ\text{C}$

<sup>5)</sup> at ● bei  $U_{CE} = 30\text{ V}$ ,  $\vartheta_c = 100^\circ\text{C}$ ,  $P_C = 65\text{ W}$  } can not occur a second breakdown ●  
<sup>6)</sup> at ● bei  $U_{CE} = 30\text{ V}$ ,  $\vartheta_c = 25^\circ\text{C}$ ,  $P_C = 70\text{ W}$  } darf nicht Sekundär-Durchbruch eintreten

<sup>7)</sup>  $f = 10\text{ MHz}$

<sup>8)</sup>  $U_{CEV}$ ;  $I_{CE} = 10\text{ mA}$ ,  $-U_{BE} = 0,8\text{ V}$

<sup>9)</sup>  $I_C = 4\text{ A}$ ,  $I_B = 0,4\text{ A}$

<sup>10)</sup>  $I_C = 10\text{ A}$ ,  $I_B = 3,3\text{ A}$

<sup>11)</sup>  $I_C = 3\text{ A}$ ,  $I_B = 0,3\text{ A}$

<sup>12)</sup>  $I_C = 10\text{ A}$ ,  $I_B = 2,0\text{ A}$

<sup>13)</sup>  $I_C = 16\text{ A}$ ,  $I_B = 3,2\text{ A}$

<sup>14)</sup>  $I_C = 10\text{ A}$ ,  $I_B = 1,25\text{ A}$

**A.F. POWER TRANSISTORS P-N-P**  
**NF-LEISTUNGSTRANSISTOREN P-N-P**

Type Typ	Maximum ratings ● Grenzdaten						$-I_{CBO}$ at $-U_{CB}$	$h_{21E}$ at $-U_{CB}$	$-I_C$	$-U_{BES}$	$-U_{CES}$	$f_T$	Case Gehäuse	
	$-U_{CEO}$	$-U_{EBO}$	$-I_C$	$-I_B$	$P_{tot}$	$\vartheta_j$	max	bei	A	max <sup>1)</sup>	max <sup>1)</sup>	min		
	V	V	A	A	W	°C	mA	V	A	V	V	MHz		
<b>KD615</b>	40	5	10	2	70	155	1,0	40 > 10	2 2	1 10	2,4	2	2	T39
<b>KD616</b>	60	5	10	2	70	155	1,0	60 > 10	2 2	1 10	2,4	2	2	T39
<b>KD617</b>	80	5	10	2	70	155	1,0	80 > 10	2 2	1 10	2,4	2	2	T39

<sup>1)</sup>  $-I_C = 10\text{ A}$ ,  $-I_B = 1\text{ A}$